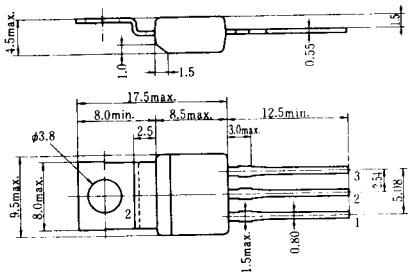
2SD757, 2SD758

シリコン NPN エピタキシャル形

低周波高電圧増幅用
2SB717, 2SB718とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
Complementary pair with 2SB717 and 2SB71



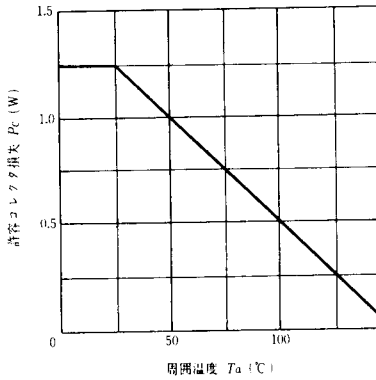
1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
3. エミッタ：Emitter
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SD757	2SD758	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	160	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	160	200	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	5	V
コレクタ電流	I_C	50	50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	100	100	mA
許容コレクタ損失	P_C	1.25	1.25	W
接合部温度	T_j	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	−45～+150	℃

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATIO
CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	2SD757 min	2SD757 typ	2SD757 max	2SD758 min	2SD758 typ	2SD758 max	Un
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=10μA, I_E=0	160	—	—	200	—	—	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=1mA, R_{BE}=∞	160	—	—	200	—	—	
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=10μA, I_C=0	5	—	—	5	—	—	
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=140V, I_E=0	—	—	10	—	—	—	
		V_{CB}=160V, I_E=0	—	—	—	—	—	10	
直流電流増幅率	h_{FE1}*	V_{CE}=5V, I_C=10mA	60	—	320	60	—	320	
	h_{FE2}	V_{CE}=5V, I_C=1mA	30	—	—	30	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=5V, I_C=10mA	—	—	1.5	—	—	1.5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=30mA, I_B=3mA	—	—	2	—	—	2	
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=5V, I_C=10mA	—	140	—	—	140	—	M
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz	—	3.8	—	—	3.8	—	

*2SD757, 2SD758はh_{FE1}の値により下記のように3区分し，現品に表示してあります。
*The 2SD757 and 2SD758 are grouped by h_{FE1} as follows.

B	C	D
60～120	100～200	160～320

HITACHI